

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
младшего научного сотрудника
в лаборатории фотоэлектрических преобразователей
Вакансия VAC_PTI_22033

Тематика исследований

Исследование и разработка в области технологии изготовления полупроводниковых материалов на основе твердых растворов АЗВ5 методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений.

Трудовая деятельность

Участие в исследованиях по разработке технологии изготовления фотоприемников мощного лазерного излучения на длину волны 1.06-1.55 мкм, на подложках фосфида индия, включая:

- разработка технологии получения стабильных четверных твердых растворов InGaAsP выращенных в области спинодального распада;
- исследования по замене туннельных переходов для каскадного фотоприемника на соединительные элементы на основе кристаллитов GaP;
- разработка технологии изготовления многокаскадных фотоприемников мощного лазерного излучения на длину волны 1.06-1.55 мкм и подложках фосфида индия;
- подготовка публикаций результатов научно-исследовательских работ в российских и зарубежных журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus; представление этих результатов на российских и международных конференциях;

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя заведующим лабораторией.

Требования к претенденту

- квалификация - магистр по специальности «Электроника и Микроэлектроника»
- стаж научной работы по специальности не менее 5 лет;
- наличие не менее 5 публикаций WoS/Scopus в рецензируемых научных изданиях за последние 3 года, и не менее 1 патента на изобретение;
- наличие опыта работы на установке эпитаксиального роста: установка газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений AIXTRON AIX-200;
- наличие опыта подготовки полупроводниковых структур для различных видов исследований (ВАХ, ТИЭЗ, СЭМ);

- наличие опыта проведения электрохимических процессов (анодирование, электрохимическое нанесение контактов);
- наличие опыта исследования характеристик полупроводниковых приборов (ВАХ);
- наличие опыта в проектировании и обслуживании электрических приборов и схем.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 23 800 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.